

● MC8LP-582PHOTS 照度測定プローブ

照度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.01～200・10³ lux、CIE n.69 Class B適合、SICRAMモジュール付。

測定範囲(lux)	0.01～199.99	～1999.9	～19999	～199.99・10 ³
分解能(lux)	0.01	0.1	1	0.01・10 ³
スペクトル範囲	標準比視感度V(λ)に一致			
クラス	B			
校正不確かさ	<4%			
f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致)	<6%			
f ₂ (余弦則に準ずる応答)	<3%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	<0.5%			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
α(温度係数) f ₅ (T)	<0.05%/K			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0～50℃			
基準規格	CIE n.69 – UNI11142 class B			



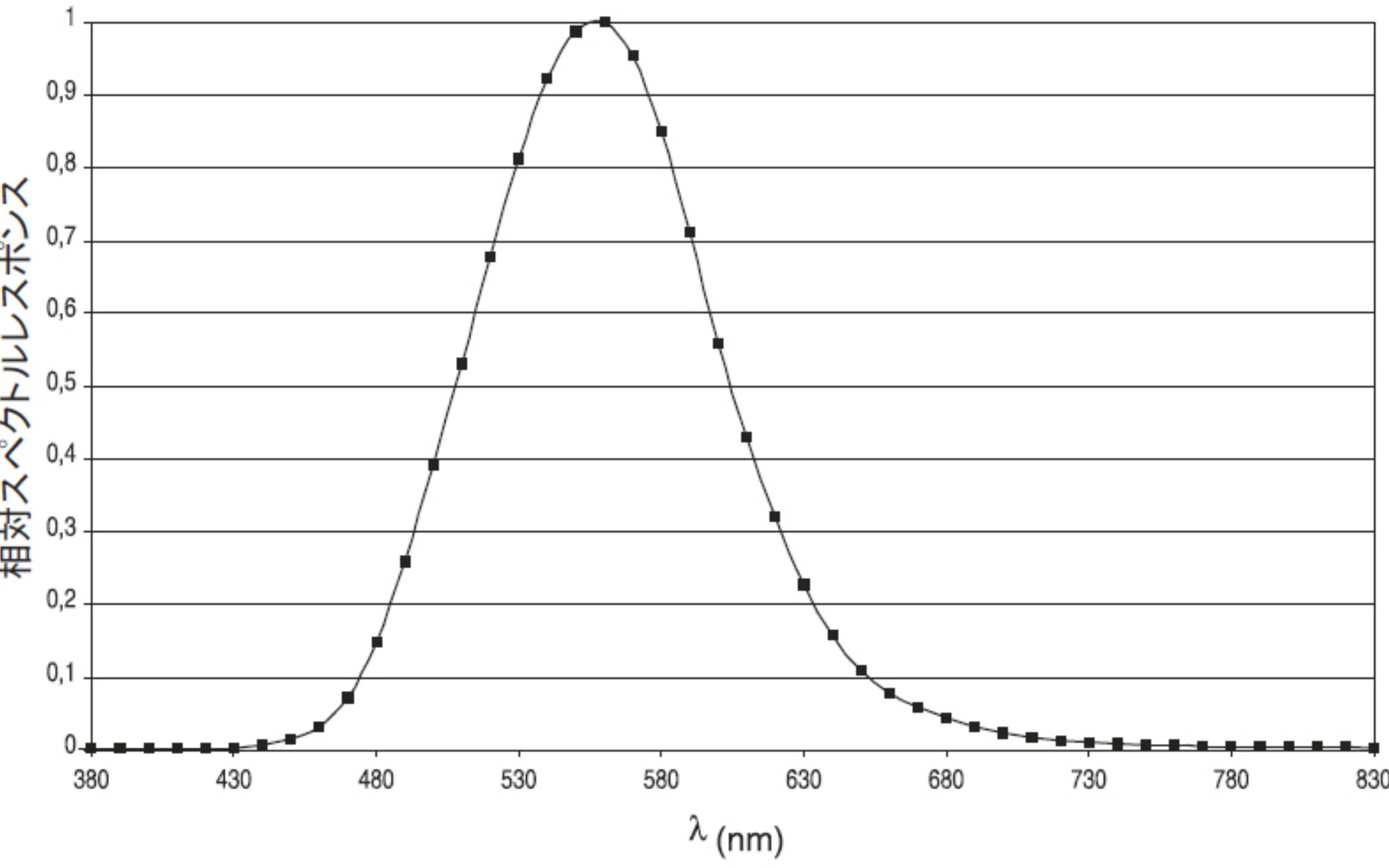
● MC8LP-582LUM2S 輝度測定用プローブ

輝度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、光角2°、測定範囲0.1～2000・10³cd/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲(cd/m ²)	0.1～1999.9	～19999	～199.99・10 ³	～1999.9・10 ³
分解能(cd/m ²)	0.1	1	0.01・10 ³	0.1・10 ³
光角	2°			
スペクトル範囲	標準比視感度V(λ)に一致			
クラス	C			
校正不確かさ	<5%			
f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致)	<8%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	<0.5%			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
α(温度係数) f ₅ (T)	<0.05%/K			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0～50℃			
基準規格	CIE n.69 – UNI11142 class C			



代表応答カーブ：照度 – 輝度



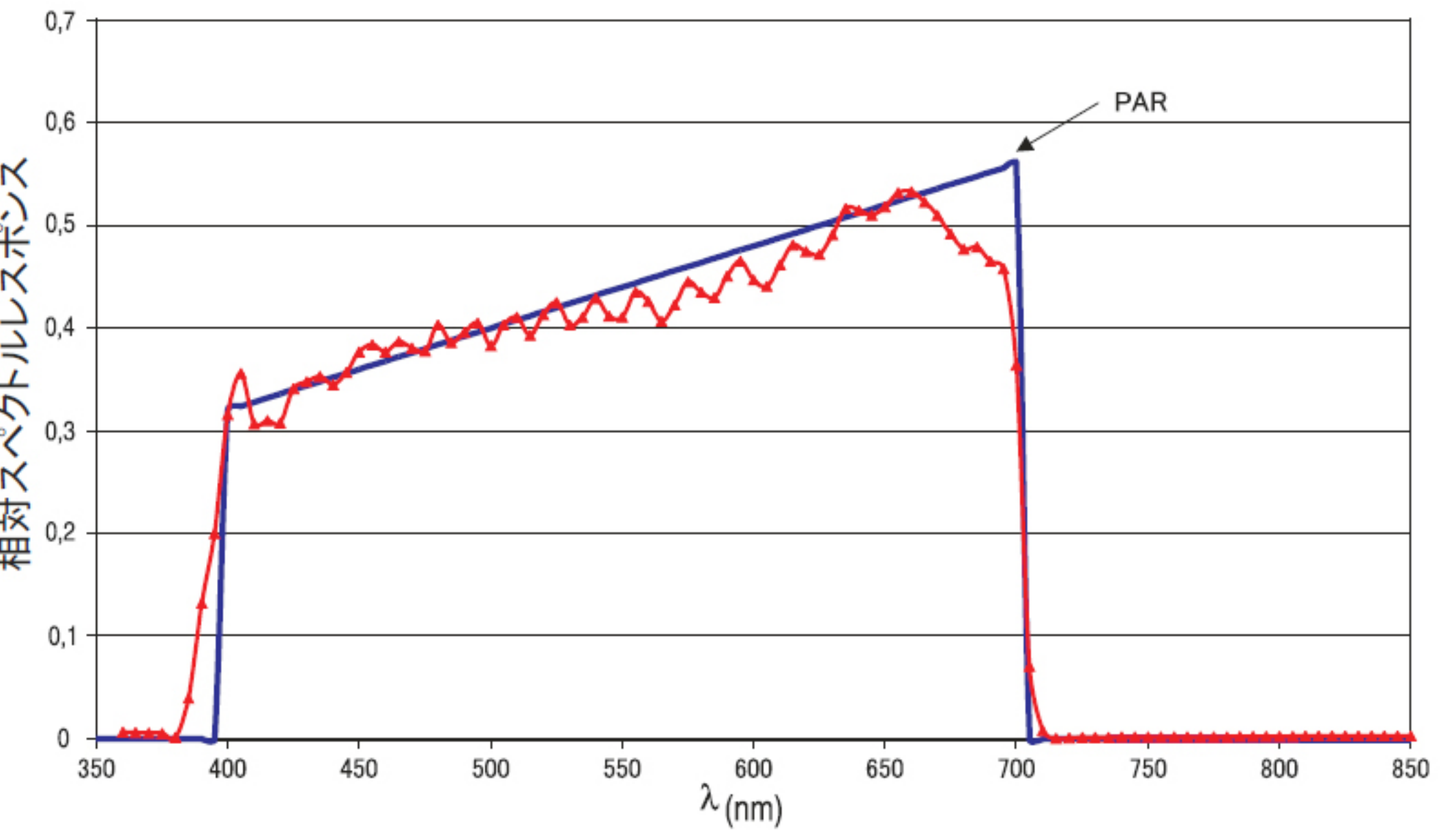
● MC8LP-582PARS 光量子（光合成エネルギー）測定用プローブ

葉緑素帯PAR(光合成有効放射、400～700nm)測定用光量子放射プローブ、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.1～10・10³ μmol・m⁻²s⁻¹、SICRAMモジュール付。

測定範囲(μmol m ⁻² s ⁻¹)	0.1～199.99	200.0～1999.9	2000～10000
分解能(μmol m ⁻² s ⁻¹)	0.01	0.1	1
スペクトル範囲	400～700nm		
校正不確かさ	<5%		
f ₁ (余弦則に準ずる応答)	<6%		
f ₃ (直線性)	<1%		
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit		
f ₅ (疲労)	<0.5%		
1年後のドリフト	<1%		
動作温度	0～50℃		



代表応答カーブ：PAR



● MC8LP-582RADS 放射照度測定プローブ

放射照度測定用プローブ、スペクトル範囲400～1050nm、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.1・10⁻³～2000W/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m ²)	0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³	1.000 ～19.999	20.00 ～199.99	200.0 ～1999.9
分解能(W/m ²)	0.1・10 ⁻³	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	400～1050nm			
校正不確かさ	<5%			
f ₁ (余弦則に準ずる応答)	<6%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0～50℃			



代表応答カーブ：RAD

